

10MHz、6V/ μ s、デュアル/クワッド
レール・トゥ・レール入力および出力
高精度C - Loadオペアンプ

特長

- レール・トゥ・レール入力/出力
- V^+ から V^- で V_{OS} が最大475 μ V
- 利得帯域幅積：10MHz
- スルーレート：6V/ μ s
- 低消費電流/アンプ：1.7mA
- 入力オフセット電流：50nA最大
- 入力バイアス電流：500nA最大
- 開ループ利得：1000V/mV最小
- 低入力ノイズ電圧：12nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ 標準
- 広い電源電圧範囲：2.2V ~ ±15V
- 大出力ドライブ電流：30mA
- 最大10,000pFの容量性負荷でも安定動作
- デュアルは8ピンPDIPおよびSOパッケージ
- クワッドは細型14ピンSOパッケージ

アプリケーション

- A/Dコンバータのドライブ
- アクティブ・フィルタ
- レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
- 低電圧信号処理
- バッテリ駆動システム

LTC、LTはリニアテクノロジー社の登録商標です。
C - Loadはリニアテクノロジー社の商標です。
RAIL-TO-RAILは日本モトローラ(株)の登録商標です。

概要

LT[®]1498/LT1499は、10MHzの利得帯域幅積や6V/ μ sのスルーレートなどを特長とするデュアル/クワッド、レール・トゥ・レール入力および出力、高精度、C - LoadTMオペアンプです。

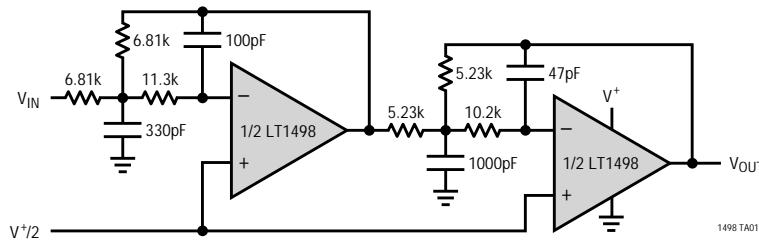
LT1498/LT1499は全電源電圧範囲で高精度性能を達成することにより、入力ダイナミック・レンジを最大にするように設計されています。LT1498/LT1499では特許取得済み手法を用いて、負電源側と正電源側の両方の入力段が調整されています。その結果、他のレール・トゥ・レール入力オペアンプよりはるかに優れた最小で97dBの同相除去を実現しています。LT1498/LT1499を単一電源12ビットA/Dコンバータの前段でユーティ・ゲイン・バッファとして使用すれば、単一3V電源システムでも、1LSB未満の誤差しか追加されないことが保証されます。

LT1498/LT1499は電源除去比が110dBであり、2.2V ~ 36Vの電源範囲で性能を維持し、3V、5V、および±15V電源に対して仕様が規定されています。入力は損傷を受けたり出力の位相反転を起こすことなく、電源レールを超えてドライブすることができます。これらのオペアンプは最大10,000pFの容量性負荷をドライブしながら安定して動作します。

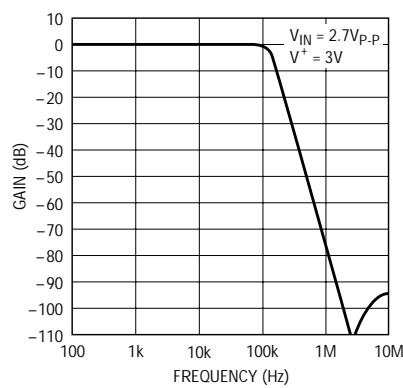
LT1498は標準デュアル・オペアンプ構成であり、8ピンPDIPおよびSOパッケージで供給されます。LT1499は標準クワッド・オペアンプ構成であり、14ピン・プラスチックSOパッケージで供給されます。これらのデバイスは多くの標準オペアンプのプラグイン互換品として使用して、入力/出力範囲と精度を改善することができます。

標準的応用例

単一電源、100kHz、4次バターワース・フィルタ



周波数応答



絶対最大定格

全電源電圧($V^+ \sim V^-$)	36V	規定温度範囲(Note 3)	- 40 ~ 85
入力電流	$\pm 10\text{mA}$	接合部温度	150
出力短絡時間(Note 1)	連続	保存温度範囲	- 65 ~ 150
動作温度範囲	- 40 ~ 85	リード温度(半田付け、10秒)	300

パッケージ/発注情報

TOP VIEW	ORDER PART NUMBER	TOP VIEW	ORDER PART NUMBER
	LT1498CN8 LT1498CS8		LT1499CS
N8 PACKAGE 8-LEAD PDIP	S8 PACKAGE 8-LEAD PLASTIC SO	S PACKAGE 14-LEAD PLASTIC SO	
$T_{JMAX} = 150^\circ\text{C}, \theta_{JA} = 130^\circ\text{C/W}$ (N8) $T_{JMAX} = 150^\circ\text{C}, \theta_{JA} = 190^\circ\text{C/W}$ (S8)		$T_{JMAX} = 150^\circ\text{C}, \theta_{JA} = 150^\circ\text{C/W}$	

ミリタリ・グレード部品に関してはお問い合わせください。

2

電気的特性

注記がない限り $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5\text{V}$ 、 0V ; $V_S = 3\text{V}$ 、 0V ; $V_{CM} = V_{OUT} = 1/2$ 電源電圧

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{OS}	Input Offset Voltage	$V_{CM} = V^+$ $V_{CM} = V^-$		150	475	μV
				150	475	μV
ΔV_{OS}	Input Offset Voltage Shift	$V_{CM} = V^-$ to V^+		150	425	μV
	Input Offset Voltage Match (Channel-to-Channel)	$V_{CM} = V^+, V^-$ (Note 4)		200	750	μV
I_B	Input Bias Current	$V_{CM} = V^+$ $V_{CM} = V^-$	0 -500	250 -250	500 0	nA
ΔI_B	Input Bias Current Shift	$V_{CM} = V^-$ to V^+		500	1000	nA
	Input Bias Current Match (Channel-to-Channel)	$V_{CM} = V^+$ (Note 4) $V_{CM} = V^-$ (Note 4)	0 -100	10 -10	100 0	nA
I_{OS}	Input Offset Current	$V_{CM} = V^+$ $V_{CM} = V^-$		5	50	nA
ΔI_{OS}	Input Offset Current Shift	$V_{CM} = V^-$ to V^+		10	100	nA
	Input Noise Voltage	0.1Hz to 10Hz		400		$\text{nV}_{\text{P-P}}$
e_n	Input Noise Voltage Density	f = 1kHz		12		$\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
i_n	Input Noise Current Density	f = 1kHz		0.3		$\text{pA}/\sqrt{\text{Hz}}$
C_{IN}	Input Capacitance			5		pF
A_{VOL}	Large-Signal Voltage Gain	$V_S = 5\text{V}, V_0 = 75\text{mV}$ to $4.8\text{V}, R_L = 10\text{k}$ $V_S = 3\text{V}, V_0 = 75\text{mV}$ to $2.8\text{V}, R_L = 10\text{k}$	600 500	3800 2000		V/mV
						V/mV

電気的特性

注記がない限り $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5V, 0V$; $V_S = 3V, 0V$; $V_{CM} = V_{OUT} = 1/2$ 電源電圧

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
CMRR	Common Mode Rejection Ratio	$V_S = 5V, V_{CM} = V^- \text{ to } V^+$	81	90		dB
		$V_S = 3V, V_{CM} = V^- \text{ to } V^+$	76	86		dB
PSRR	Power Supply Rejection Ratio	$V_S = 5V, V_{CM} = V^- \text{ to } V^+$	75	91		dB
		$V_S = 3V, V_{CM} = V^- \text{ to } V^+$	70	86		dB
PSRR	Power Supply Rejection Ratio	$V_S = 2.2V \text{ to } 12V, V_{CM} = V_0 = 0.5V$	88	105		dB
		$V_S = 2.2V \text{ to } 12V, V_{CM} = V_0 = 0.5V$	82	103		dB
V_{OL}	Output Voltage Swing (Low) (Note 5)	No Load		14	30	mV
		$I_{SINK} = 0.5mA$		35	70	mV
		$I_{SINK} = 2.5mA$		90	200	mV
V_{OH}	Output Voltage Swing (High) (Note 5)	No Load		2.5	10	mV
		$I_{SOURCE} = 0.5mA$		50	100	mV
		$I_{SOURCE} = 2.5mA$		140	250	mV
I_{SC}	Short-Circuit Current	$V_S = 5V$		± 12.5	± 24	mA
		$V_S = 3V$		± 12.0	± 19	mA
I_S	Supply Current per Amplifier			1.7	2.2	mA
GBW	Gain-Bandwidth Product (Note 6)			6.8	10.5	MHz
SR	Slew Rate (Note 7)	$V_S = 5V, A_V = -1, R_L = \text{Open}, V_0 = 4V$		2.6	4.5	V/ μ s
		$V_S = 3V, A_V = -1, R_L = \text{Open}$		2.3	4.0	V/ μ s

注記がない限り $0^\circ\text{C} \leq T_A \leq 70^\circ\text{C}$ 、 $V_S = 5V, 0V$; $V_S = 3V, 0V$; $V_{CM} = V_{OUT} = 1/2$ 電源電圧

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{OS}	Input Offset Voltage	$V_{CM} = V^+$	●	175	650	μ V
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$	●	175	650	μ V
$V_{OS\ TC}$	Input Offset Voltage Drift (Note 2)		●	0.5	2.5	μ V/ $^\circ\text{C}$
		$V_{CM} = V^+$	●	1.5	4.0	μ V/ $^\circ\text{C}$
ΔV_{OS}	Input Offset Voltage Shift	$V_{CM} = V^- + 0.1V \text{ to } V^+$	●	170	600	μ V
		$V_{CM} = V^- + 0.1V, V^+ \text{ (Note 4)}$	●	200	900	μ V
I_B	Input Bias Current	$V_{CM} = V^+$	●	0	275	nA
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$	●	-600	-275	nA
ΔI_B	Input Bias Current Shift	$V_{CM} = V^- + 0.1V \text{ to } V^+$	●	550	1200	nA
		$V_{CM} = V^+ \text{ (Note 4)}$	●	0	15	nA
		$V_{CM} = V^- + 0.1V \text{ (Note 4)}$	●	-170	-15	nA
I_{OS}	Input Offset Current	$V_{CM} = V^+$	●	10	85	nA
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$	●	10	85	nA
ΔI_{OS}	Input Offset Current Shift	$V_{CM} = V^- + 0.1V \text{ to } V^+$	●	20	170	nA
		$V_{CM} = V^- + 0.1V \text{ to } V^+$	●	-170	-15	nA
A_{VOL}	Large-Signal Voltage Gain	$V_S = 5V, V_0 = 75mV \text{ to } 4.8V, R_L = 10k$	●	500	2500	V/mV
		$V_S = 3V, V_0 = 75mV \text{ to } 2.8V, R_L = 10k$	●	400	2000	V/mV
CMRR	Common Mode Rejection Ratio	$V_S = 5V, V_{CM} = V^- + 0.1V \text{ to } V^+$	●	78	89	dB
		$V_S = 3V, V_{CM} = V^- + 0.1V \text{ to } V^+$	●	73	85	dB
PSRR	Power Supply Rejection Ratio	$V_S = 5V, V_{CM} = V^- + 0.1V \text{ to } V^+$	●	74	90	dB
		$V_S = 3V, V_{CM} = V^- + 0.1V \text{ to } V^+$	●	69	86	dB
PSRR	Power Supply Rejection Ratio	$V_S = 2.3V \text{ to } 12V, V_{CM} = V_0 = 0.5V$	●	86	102	dB
		$V_S = 2.3V \text{ to } 12V, V_{CM} = V_0 = 0.5V$	●	80	102	dB

電気的特性

注記がない限り $0 \leq T_A \leq 70$ 、 $V_S = 5V, 0V$; $V_S = 3V, 0V$; $V_{CM} = V_{OUT} = 1/2$ 電源電圧

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{OL}	Output Voltage Swing (Low) (Note 5)	No Load	●	17	35	mV	
		$I_{SINK} = 0.5mA$	●	40	80	mV	
		$I_{SINK} = 2.5mA$	●	110	220	mV	
V_{OH}	Output Voltage Swing (High) (Note 5)	No Load	●	3.5	15	mV	
		$I_{SOURCE} = 0.5mA$	●	55	120	mV	
		$I_{SOURCE} = 2.5mA$	●	160	300	mV	
I_{SC}	Short-Circuit Current	$V_S = 5V$ $V_S = 3V$	● ●	± 12 ± 10	± 23 ± 20	mA mA	mA
I_S	Supply Current per Amplifier		●	1.9	2.6	mA	mA
GBW	Gain-Bandwidth Product (Note 6)		●	6.1	9	MHz	MHz
SR	Slew Rate (Note 7)	$V_S = 5V, A_V = -1, R_L = Open, V_O = 4V$	●	2.5	4.0	$V/\mu s$	$V/\mu s$
		$V_S = 3V, A_V = -1, R_L = Open$	●	2.2	3.5	$V/\mu s$	$V/\mu s$

注記がない限り $-40 \leq T_A \leq 85$ 、 $V_S = 5V, 0V$; $V_S = 3V, 0V$; $V_{CM} = V_{OUT} = 1/2$ 電源電圧 (Note 3)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{OS}	Input Offset Voltage	$V_{CM} = V^+$	●	250	750	μV	μV
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$	●	250	750	μV	μV
$V_{OS\ TC}$	Input Offset Voltage Drift (Note 2)	$V_{CM} = V^+$	●	0.5	2.5	$\mu V/\text{°C}$	$\mu V/\text{°C}$
		$V_{CM} = V^-$	●	1.5	4.0	$\mu V/\text{°C}$	$\mu V/\text{°C}$
ΔV_{OS}	Input Offset Voltage Shift	$V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	250	650	μV	μV
	Input Offset Voltage Match (Channel-to-Channel)	$V_{CM} = V^- + 0.1V, V^+ (Note 4)$	●	300	1500	μV	μV
I_B	Input Bias Current	$V_{CM} = V^+$	●	0	350	750	nA
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$	●	-750	-350	0	nA
ΔI_B	Input Bias Current Shift	$V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	700	1500	nA	nA
		$V_{CM} = V^+ (Note 4)$	●	0	30	180	nA
		$V_{CM} = V^- + 0.1V (Note 4)$	●	-180	-30	0	nA
I_{OS}	Input Offset Current	$V_{CM} = V^+$	●	15	90	nA	nA
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$	●	15	90	nA	nA
ΔI_{OS}	Input Offset Current Shift	$V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	30	180	nA	nA
A_{VOL}	Large-Signal Voltage Gain	$V_S = 5V, V_O = 75mV$ to $4.8V, R_L = 10k$	●	400	2500	V/mV	V/mV
		$V_S = 3V, V_O = 75mV$ to $2.8V, R_L = 10k$	●	300	2000	V/mV	V/mV
CMRR	Common Mode Rejection Ratio	$V_S = 5V, V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	77	86	dB	dB
		$V_S = 3V, V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	73	81	dB	dB
	CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 4)	$V_S = 5V, V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	72	86	dB	dB
		$V_S = 3V, V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	69	83	dB	dB
PSRR	Power Supply Rejection Ratio	$V_S = 2.5V$ to $12V, V_{CM} = V_O = 0.5V$	●	86	100	dB	dB
		$V_S = 2.5V$ to $12V, V_{CM} = V_O = 0.5V$	●	80	100	dB	dB
V_{OL}	Output Voltage Swing (Low) (Note 5)	No Load	●	18	40	mV	mV
		$I_{SINK} = 0.5mA$	●	45	80	mV	mV
		$I_{SINK} = 2.5mA$	●	110	220	mV	mV
V_{OH}	Output Voltage Swing (High) (Note 5)	No Load	●	3.5	15	mV	mV
		$I_{SOURCE} = 0.5mA$	●	60	120	mV	mV
		$I_{SOURCE} = 2.5mA$	●	170	300	mV	mV

電気的特性

注記がない限り $-40 \leq T_A \leq 85$ 、 $V_S = 5V, 0V$; $V_S = 3V, 0V$; $V_{CM} = V_{OUT} = 1/2$ 電源電圧 (Note 3)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{SC}	Short-Circuit Current	$V_S = 5V$ $V_S = 3V$	●	± 7.5	± 15		mA
			●				
I_S	Supply Current per Amplifier		●		2.0	2.7	mA
GBW	Gain-Bandwidth Product (Note 6)		●	5.8	8.5		MHz
SR	Slew Rate (Note 7)	$V_S = 5V, A_V = -1, R_L = \text{Open}, V_0 = 4V$ $V_S = 3V, A_V = -1, R_L = \text{Open}$	●	2.2	3.6	3.2	V/ μ s
			●				

注記がない限り $T_A = 25$ 、 $V_S = \pm 15V$ 、 $V_{CM} = 0V$ 、 $V_{OUT} = 0V$

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{OS}	Input Offset Voltage	$V_{CM} = V^+$ $V_{CM} = V^-$		200	800	800	μ V
ΔV_{OS}	Input Offset Voltage Shift	$V_{CM} = V^-$ to V^+		150	650	650	μ V
	Input Offset Voltage Match (Channel-to-Channel)	$V_{CM} = V^+, V^-$ (Note 4)		250	1400	1400	μ V
I_B	Input Bias Current	$V_{CM} = V^+$ $V_{CM} = V^-$		0 -550	250 -250	550 0	nA
ΔI_B	Input Bias Current Shift	$V_{CM} = V^-$ to V^+		500	1100	1100	nA
I_{os}	Input Offset Current	$V_{CM} = V^+$ $V_{CM} = V^-$		6	60	60	nA
ΔI_{os}	Input Offset Current Shift	$V_{CM} = V^-$ to V^+		12	120	120	nA
	Input Noise Voltage	0.1Hz to 10Hz			400		nV _{P-P}
e_n	Input Noise Voltage Density	f = 1kHz			12		nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
i_n	Input Noise Current Density	f = 1kHz			0.3		pA/ $\sqrt{\text{Hz}}$
A_{VOL}	Large-Signal Voltage Gain	$V_0 = -14.5V$ to $14.5V, R_L = 10k$ $V_0 = -10V$ to $10V, R_L = 2k$		1000 500	5200 2300		V/mV
	Channel Separation	$V_0 = -10V$ to $10V, R_L = 2k$		116	130		dB
CMRR	Common-Mode Rejection Ratio	$V_{CM} = V^-$ to V^+		93	106		dB
PSRR	Power Supply Rejection Ratio	$V_S = \pm 5V$ to $\pm 15V$		89	110		dB
V_{OL}	Output Voltage Swing (Low) (Note 5)	No Load $I_{SINK} = 0.5mA$ $I_{SINK} = 10mA$		18 40 230	30 80 500		mV
V_{OH}	Output Voltage Swing (High) (Note 5)	No Load $I_{SINK} = 0.5mA$ $I_{SINK} = 10mA$		2.5 55 420	10 120 800		mV
I_{sc}	Short-Circuit Current			± 15	± 30		mA
I_S	Supply Current per Amplifier				1.8	2.5	mA
GBW	Gain-Bandwidth Product (Note 6)			6.8	10.5		MHz
SR	Slew Rate	$A_V = -1, R_L = \text{Open}, V_0 = \pm 10V$ Measure at $V_0 = \pm 5V$		3.5	6		V/ μ s

電気的特性

注記がない限り $0 \leq T_A \leq 70$ 、 $V_S = \pm 15V$ 、 $V_{CM} = 0V$ 、 $V_{OUT} = 0V$

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{OS}	Input Offset Voltage	$V_{CM} = V^+$	● ●	200 200	900 900	μV μV
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$				
$V_{OS\ TC}$	Input Offset Voltage Drift (Note 2)	$V_{CM} = V^+$	● ●	1.0 2.0	3.5 5.0	$\mu V/^{\circ}C$ $\mu V/^{\circ}C$
ΔV_{OS}	Input Offset Voltage Shift	$V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	200	750	μV
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$, V^+ (Note 4)				
I_B	Input Bias Current	$V_{CM} = V^+$	● ●	0 -675	300 -300	nA nA
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$				
ΔI_B	Input Bias Current Shift	$V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	600	1350	nA
		$V_{CM} = V^+$ (Note 4) $V_{CM} = V^- + 0.1V$ (Note 4)				
I_{OS}	Input Offset Current	$V_{CM} = V^+$	● ●	15 15	90 90	nA nA
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$				
ΔI_{OS}	Input Offset Current Shift	$V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	30	180	nA
		$V_O = -14.5V$ to $14.5V$, $R_L = 10k$ $V_O = -10V$ to $10V$, $R_L = 2k$				
A_{VOL}	Large-Signal Voltage Gain	$V_O = -10V$ to $10V$, $R_L = 2k$	● ●	900 400	5000 2000	V/mV V/mV
	Channel Separation	$V_O = -10V$ to $10V$, $R_L = 2k$	●	112	125	dB
$CMRR$	Common Mode Rejection Ratio	$V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	92	103	dB
$PSRR$	Power Supply Rejection Ratio	$V_S = \pm 5V$ to $\pm 15V$	●	88	103	dB
V_{OL}	Output Voltage Swing (Low) (Note 5)	No Load $I_{SINK} = 0.5mA$ $I_{SINK} = 10mA$	● ● ●	18 45 270	40 90 520	mV mV mV
V_{OH}	Output Voltage Swing (High) (Note 5)	No Load $I_{SOURCE} = 0.5mA$ $I_{SOURCE} = 10mA$	● ● ●	3.5 60 480	15 120 1000	mV mV mV
I_{SC}	Short-Circuit Current		●	± 12	± 28	mA
I_S	Supply Current per Amplifier		●		1.9	2.8
GBW	Gain-Bandwidth Product (Note 6)		●	6.1	9	MHz
SR	Slew Rate	$A_V = -1$, $R_L = \text{Open}$, $V_O = \pm 10V$ Measured at $V_O = \pm 5V$	●	3.4	5.3	$V/\mu s$

電気的特性

注記がない限り $-40 \leq T_A \leq 85$ 、 $V_S = \pm 15V$ 、 $V_{CM} = 0V$ 、 $V_{OUT} = 0V$ (Note 3)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{OS}	Input Offset Voltage	$V_{CM} = V^+$	●	300	950	μV
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$				
$V_{OS\ TC}$	Input Offset Voltage Drift (Note 2)	$V_{CM} = V^+$	●	1.0	3.5	$\mu V/^\circ C$
ΔV_{OS}	Input Offset Voltage Shift	$V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	250	850	μV
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$, V^+ (Note 4)				
I_B	Input Bias Current	$V_{CM} = V^+$	●	0	350	nA
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$				
ΔI_B	Input Bias Current Shift	$V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	700	1600	nA
		$V_{CM} = V^+$ (Note 4)				
ΔI_B	Input Bias Current Match (Channel-to-Channel)	$V_{CM} = V^- + 0.1V$ (Note 4)	●	0	20	nA
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$ (Note 4)				
I_{OS}	Input Offset Current	$V_{CM} = V^+$	●	15	100	nA
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$				
ΔI_{OS}	Input Offset Current Shift	$V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	30	200	nA
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+				
A_{VOL}	Large-Signal Voltage Gain	$V_O = -14.5V$ to $14.5V$, $R_L = 10k$	●	800	5000	V/mV
		$V_O = -10V$ to $10V$, $R_L = 2k$				
	Channel Separation	$V_O = -10V$ to $10V$, $R_L = 2k$	●	110	120	dB
		$V_O = -10V$ to $10V$, $R_L = 2k$				
$CMRR$	Common Mode Rejection Ratio	$V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+	●	90	101	dB
		$V_{CM} = V^- + 0.1V$ to V^+				
$PSRR$	Power Supply Rejection Ratio	$V_S = \pm 5V$ to $\pm 15V$	●	88	100	dB
		$V_S = \pm 5V$ to $\pm 15V$				
V_{OL}	Output Voltage Swing (Low) (Note 5)	No Load	●	25	50	mV
		$I_{SINK} = 0.5mA$				
		$I_{SINK} = 10mA$				
V_{OH}	Output Voltage Swing (High) (Note 5)	No Load	●	3.5	15	mV
		$I_{SOURCE} = 0.5mA$				
		$I_{SOURCE} = 10mA$				
I_{SC}	Short-Circuit Current		●	± 10	± 18	mA
I_S	Supply Current per Amplifier		●	2.0	3.0	mA
GBW	Gain-Bandwidth Product (Note 6)		●	5.8	8.5	MHz
SR	Slew Rate	$A_V = -1$, $R_L = Open$, $V_O = \pm 10V$, Measure at $V_O = \pm 5V$	●	3	4.75	$V/\mu s$

は全動作温度範囲の規格値を意味する。

Note 1 : 出力が無限に短絡されるときは、接合部温度を絶対最大定格以下に抑えるために、ヒートシンクが必要な場合がある。

Note 2 : このパラメータは100%テストされていない。

Note 3 : LT1498/LT1499はこれらの拡張温度制限範囲に適合するように設計され、特性が定められ、適合することが見込まれているが、-40と85ではテストされていない。保証されたグレード・デバイスが用意されていますので問い合わせください。

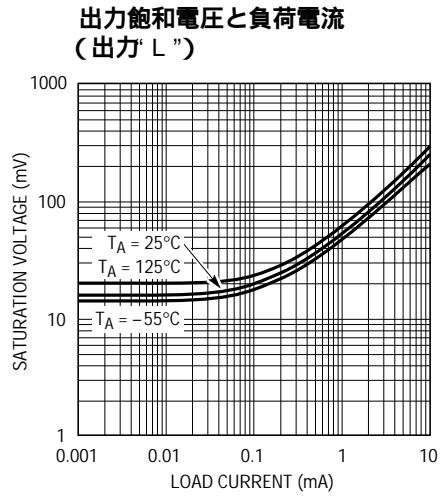
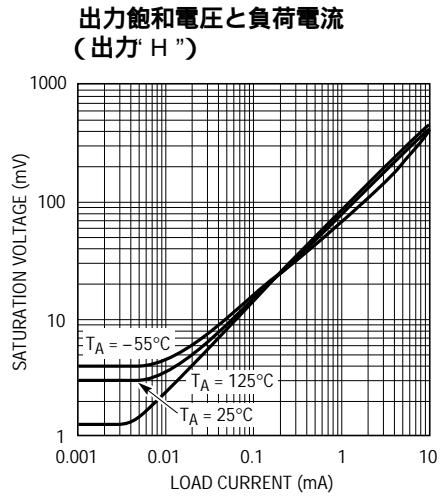
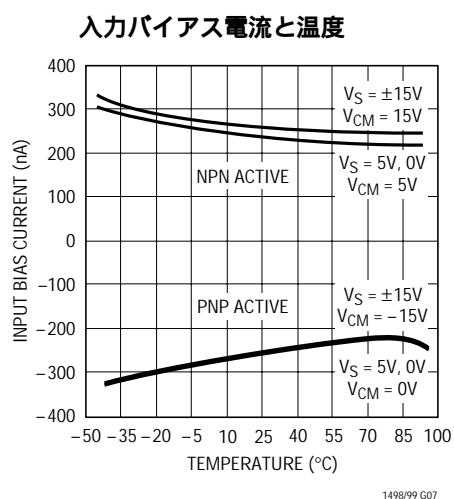
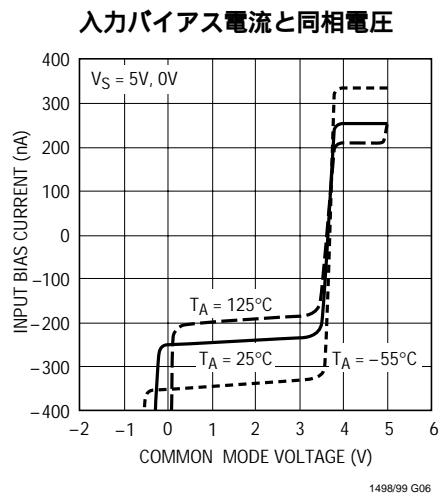
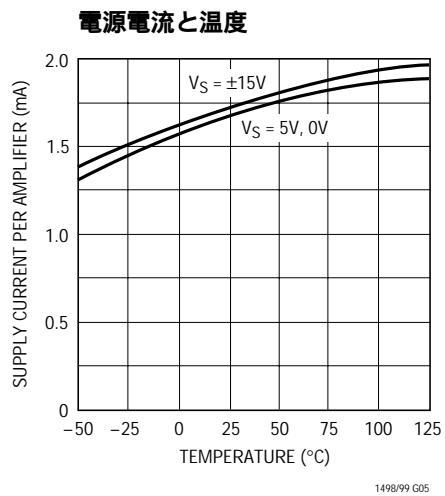
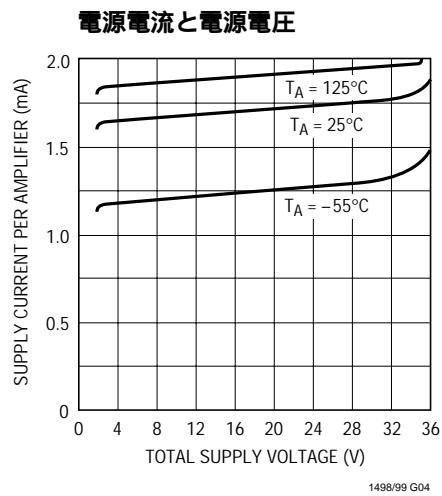
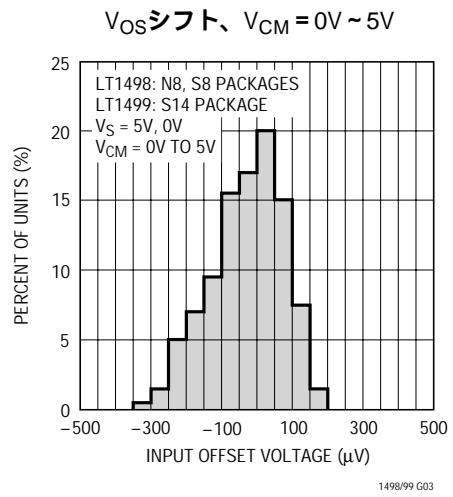
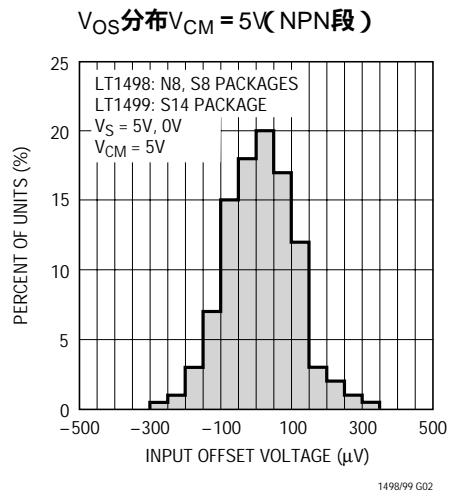
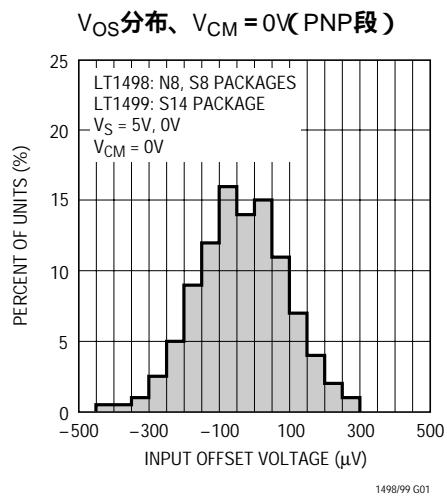
Note 4 : マッチング・パラメータは、LT1499ではアンプAとDおよびBとC間の差、LT1498では2つのアンプ間の差である。

Note 5 : 出力電圧振幅は出力と電源レール間で測定される。

Note 6 : $V_S = 3V$ 、 $V_S = \pm 5V$ のGBWのリミットは5Vでのテストとの相関で保証されている。

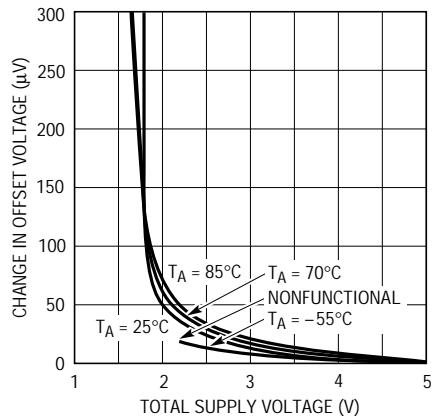
Note 7 : $V_S = 3V$ 、 $V_S = 5V$ のスルーレートのリミットは、 $\pm 15V$ でのテストとの相関で保証されている。

標準的性能特性



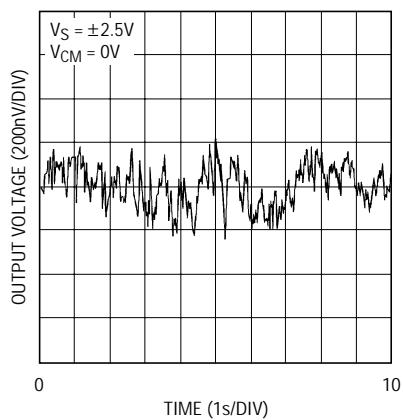
標準的性能特性

最小電源電圧



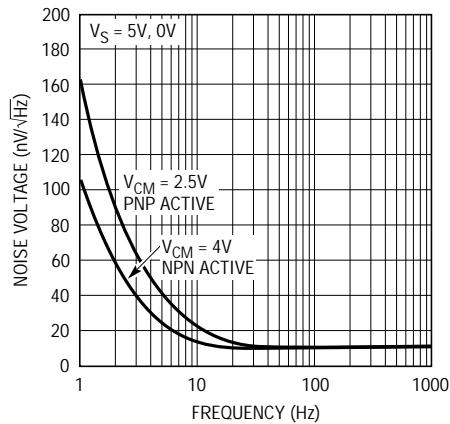
1498/99 G10

0.1Hz ~ 10Hz 出力電圧ノイズ



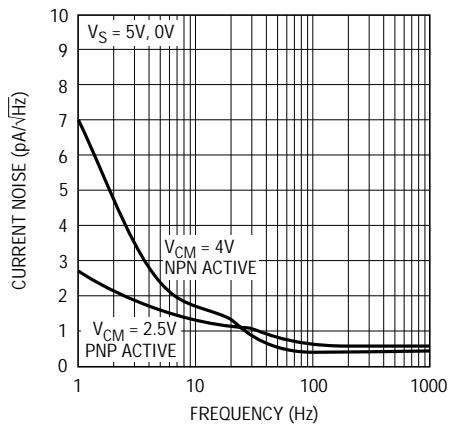
1498/99 G11

ノイズ電圧スペクトラム



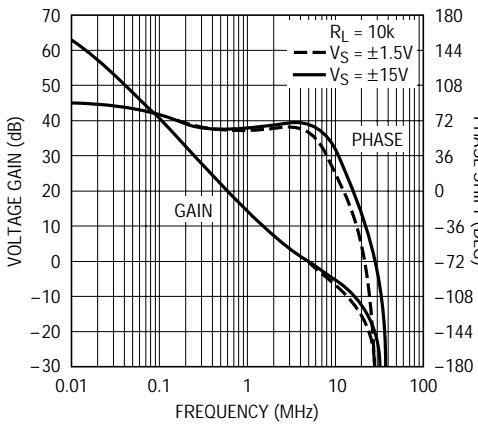
1498/99 G12

ノイズ電流スペクトラム



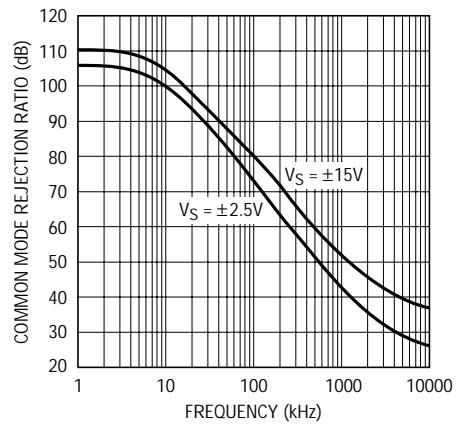
1498/99 G13

利得および位相と周波数



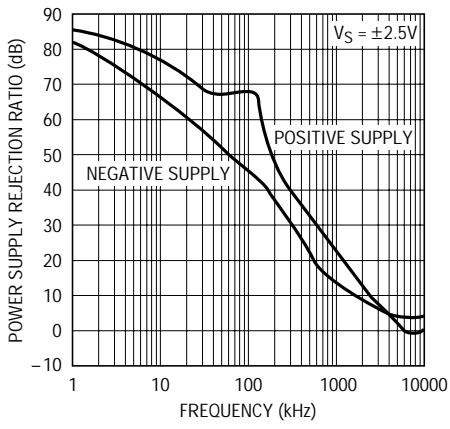
1498/99 G14

CMRRと周波数



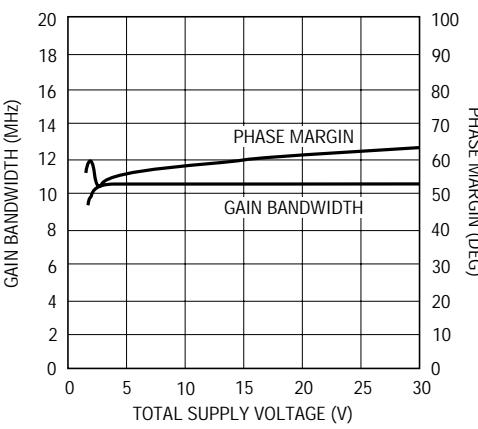
1498/99 G15

PSRRと周波数



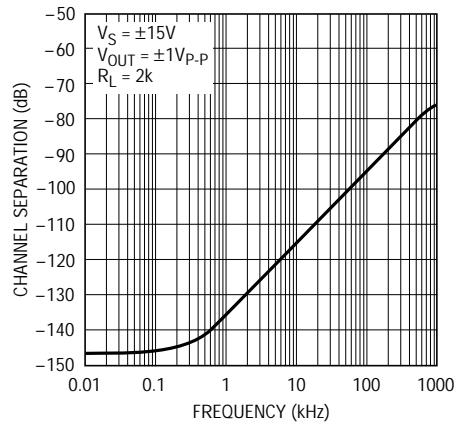
1498/99 G16

利得帯域幅および位相マージン と電源電圧



1498/99 G17

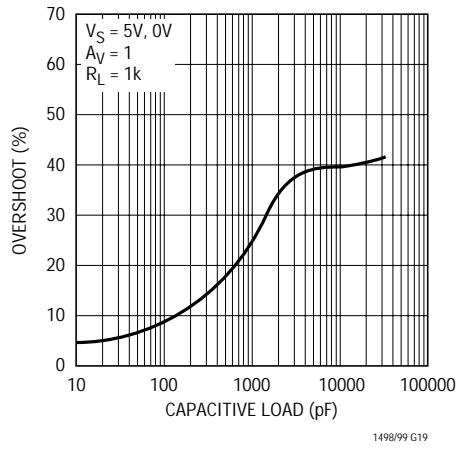
チャネルレセパレーションと周波数



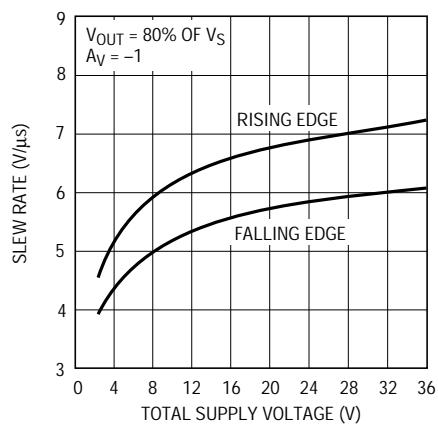
1498/99 G18

標準的性能特性

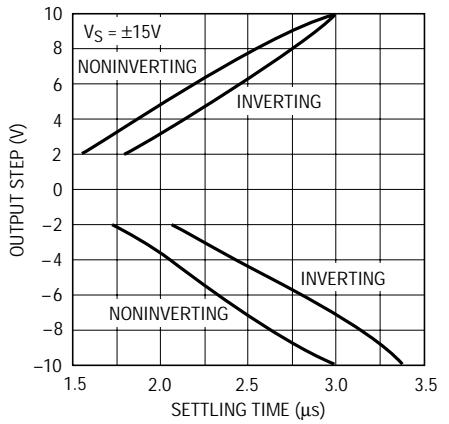
容量性負荷駆動



スルーレートと電源電圧

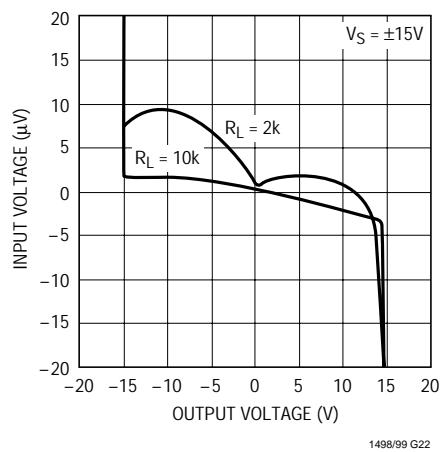


出力ステップと0.01%へのセトリング・タイム

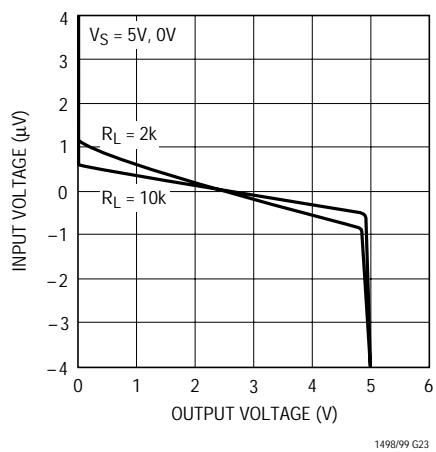


2

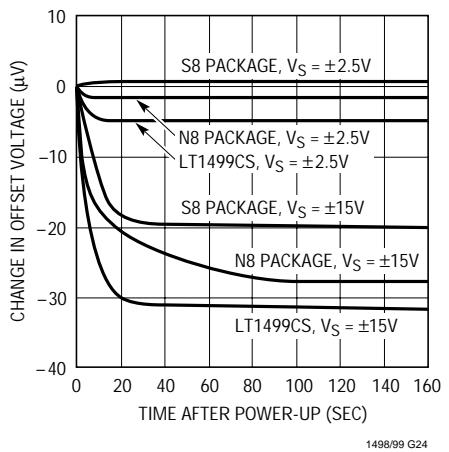
開ループ利得



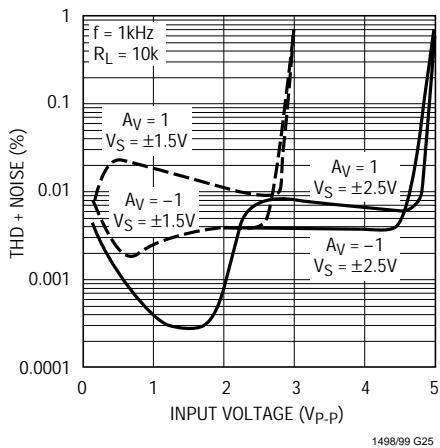
開ループ利得



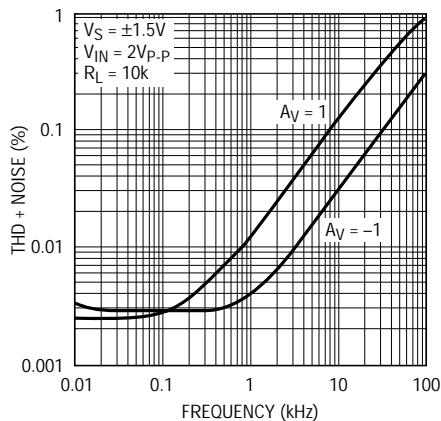
ウォームアップ・ドリフトと時間



全高調波歪み + ノイズとビーグ・ツー・ピーク電圧

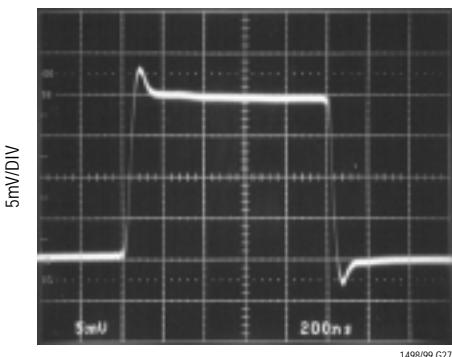


全高調波歪み + ノイズと周波数



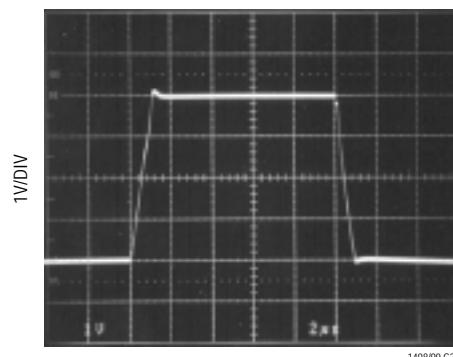
標準的性能特性

5V小信号応答



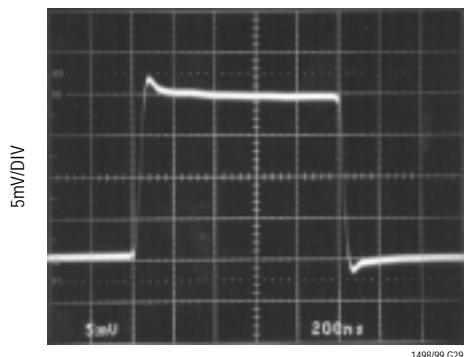
$V_S = 5V$
 $A_V = 1$
 $V_{IN} = 20mV_{p,p}$ AT 50kHz
 $R_L = 1k$

5V大信号応答



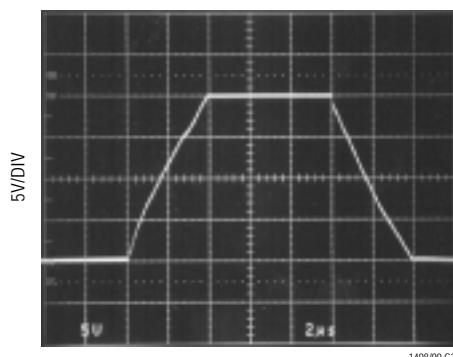
$V_S = 5V$
 $A_V = 1$
 $V_{IN} = 4V_{p,p}$ AT 10kHz
 $R_L = 1k$

±15V小信号応答



$V_S = \pm 15V$
 $A_V = 1$
 $V_{IN} = 20mV_{p,p}$ AT 50kHz
 $R_L = 1k$

±15V大信号応答



$V_S = \pm 15V$
 $A_V = 1$
 $V_{IN} = 20V_{p,p}$ AT 10kHz
 $R_L = 1k$

アプリケーション情報

レール・トゥ・レール入力および出力

LT1498/LT1499は負電源から正電源までの入力および出力信号範囲でフルに動作します。図1にアンプの簡略図を示します。入力段はPNP段(Q1/Q2)とNPN段(Q3/Q4)の2個の差動アンプで構成されており、これらは入力同相電圧の異なった範囲でアクティブになります。コンプリメンタリ・エミッタ接地出力段(Q14/Q15)を採用しているため、出力はレール・トゥ・レールで振幅します。これらのデバイスはリニアテクノロジー独自のコンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを駆使して製造されており、出力デバイス(Q14/Q15)できわめて近似したDCおよびAC特性が保証されています。

PNP差動入力ペアは、負電源から正電源より約1.3V低い電圧までの範囲の入力同相電圧 V_{CM} に対してアクティブです。 V_{CM} がさらに正電源の方向に移動すると、トランジスタQ5がテール電流 $I1$ を電流ミラーQ6/Q7に転送してNPN差動ペアをアクティブにすると、PNP差動ペアは入力同相範囲の正電源までの残りの部分で非アクティブになります。出力はコンプリメンタリ・エミッタ接地段で構成されており、出力はレール・トゥ・レールで振幅することができます。コンデンサC1とC2は局部帰還ループを形成し、高周波での出力インピーダンスを低下させます。

アプリケーション情報

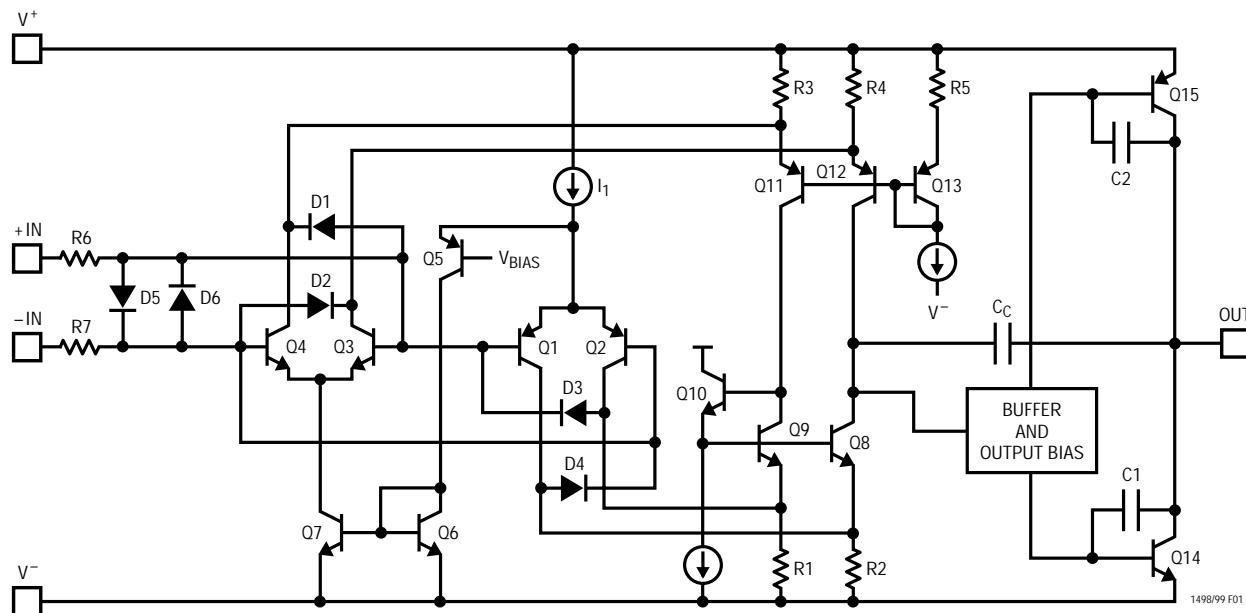


図1. LT1498 簡略図

2

入力オフセット電圧

オフセット電圧はどの段がアクティブになるかに応じて変化します。入力オフセットは不規則ですが $475\mu\text{V}$ 以下に調整されています。アンプの高精度特性を維持するために、単一5V電源では全入力同相範囲(CMRR)における V_{OS} の変化は $425\mu\text{V}$ 以下になることが保証されています。

入力バイアス電流

前述したとおり、入力バイアス電流の極性も入力同相電圧に依存します。PNP差動ペアがアクティブになると、入力ピンから入力バイアス電流が流れ出します。入力バイアス電流はNPN入力段がアクティブなときには反対方向に流れます。入力バイアス電流によるオフセット誤差は、非反転および反転入力ソース・インピーダンスを等しくすることによって、最小限に抑えることができます。これにより、入力オフセット電流が入力バイアス電流よりはるかに少なくなるため誤差が小さくなります。

オーバードライブ保護

入力電圧が電源電圧を超えたときに、出力が極性を反転させないようにするために、2組の交差ダイオードD1~D4が採用されています。入力電圧がいずれかの電源電

圧を約700mVだけ超えると、D1/D2またはD3/D4がターンオンして出力を適切な極性に強制します。位相反転保護を適切に動作させるには、入力電流は5mA未満でなければなりません。また、アンプが過度にオーバードライブされる場合は、外部抵抗を使用してオーバードライブ電流を制限しなければなりません。

さらにLT1498/LT1499の入力段は、1組のバック・トゥ・バック・ダイオード(D5/D6)によって保護されています。0.7V以上の差動電圧が入力に加えられると、これらのダイオードがターンオンし、入力トランジスタのツェナー・ブレイクダウンを防止します。D5/D6の電流は10mA未満に制限しなければなりません。内部抵抗R6およびR7(合計700Ω)は、7V以下の差動入力信号の入力電流を制限します。これより大きい入力レベルの場合は、一方または両方の入力に直列に抵抗を接続して電流を制限しなければなりません。ワーストケースの差動入力電圧は、通常出力がグランドに短絡したときに発生します。さらに、アンプはすべてのピンで最大3kVのESDに対して保護されています。

容量性負荷

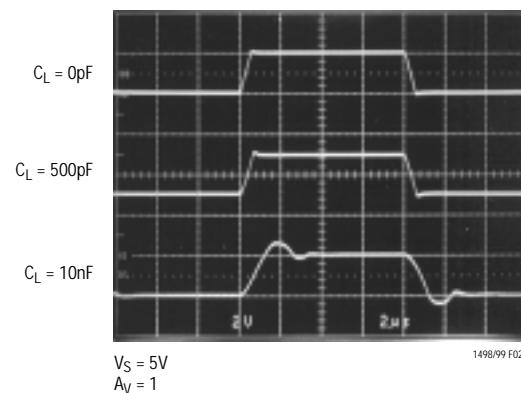
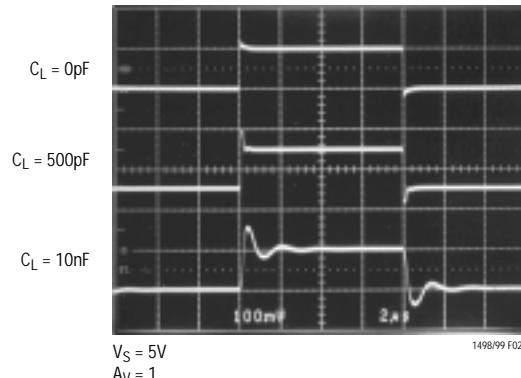
LT1498/LT1499は使いやすい設計になっています。アンプはユニティゲインで発振することなく、10nF以上の容

アプリケーション情報

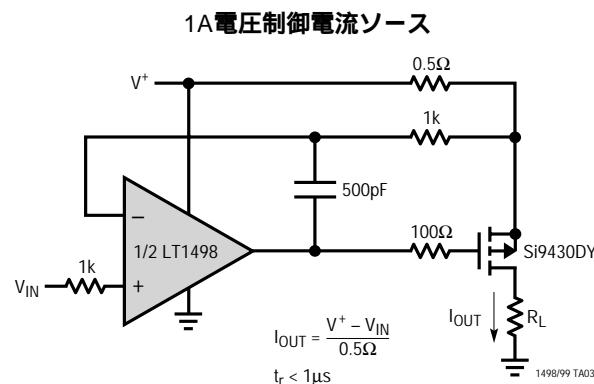
量性負荷をドライブできます。重い容量性負荷をドライブするときには、帯域幅が狭くなってしまって安定性を維持します。図2aと2bに、容量性負荷を接続した小信号および大信号条件でのデバイスの安定性を示します。10nFの容量性負荷を接続した場合の小信号および大信号過渡応答とも良好です。

帰還部品

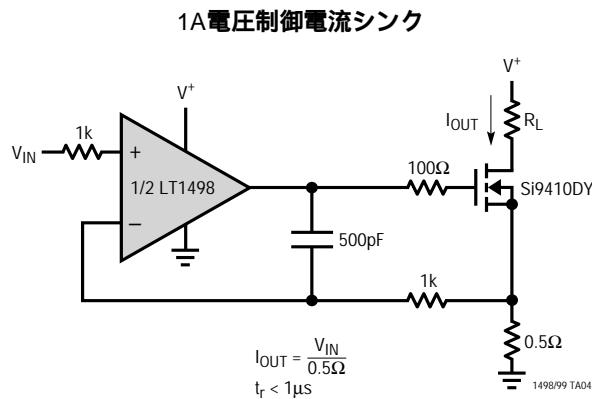
帰還負荷の影響を小さくするために、高い値の帰還抵抗を使用して利得を設定することができます。ただし、帰還抵抗と反転入力の全入力容量によって形成されるポールがアンプの安定性を損なわぬよう注意しなければなりません。たとえば、2本の30k抵抗で設定された非反転利得2のLT1498/LT1499は、おそらく全入力容量10pF(入力容量5pF + ボード容量5pF)で発振するはずです。アンプは交差周波数が2.5MHz、利得6dBでの位相マージンが60°です。帰還抵抗とこの全入力容量により1.06MHzでポールが形成され、それによって2.5MHzで67°の位相シフトが生じます。この解決法は簡単で、抵抗値を小さくするか10pF以上の帰還コンデンサを追加します。



標準的応用例

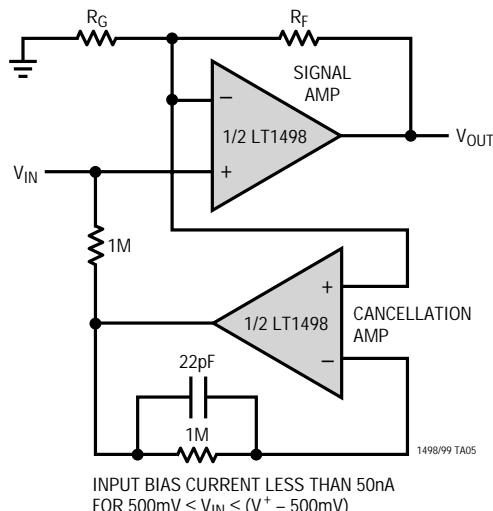


標準的応用例



2

入力バイアス電流のキャンセル



標準的応用例

双方向電流センサ

バッテリ駆動システム用双方向電流センサを図3に示します。2つの出力があり、1つは充電電流に比例し、もう1つは放電電流に比例します。この回路はLT1498のレール・トゥ・レール入力範囲と位相反転保護を活用しています。充電サイクル中、オペアンプA1は R_A の電圧を($I_L \times R_{SENSE}$)に強制します。この電圧は R_B/R_A の比に

よって、CHARGE OUTで増幅されます。このモードではA2の出力は“H”になったままで、A2の(+)入力が正電源を超えてても、Q2をオフに、DISCHARGE OUTを“L”に保持します。放電サイクル中、A2およびQ2はアクティブで動作は充電サイクルに似ています。

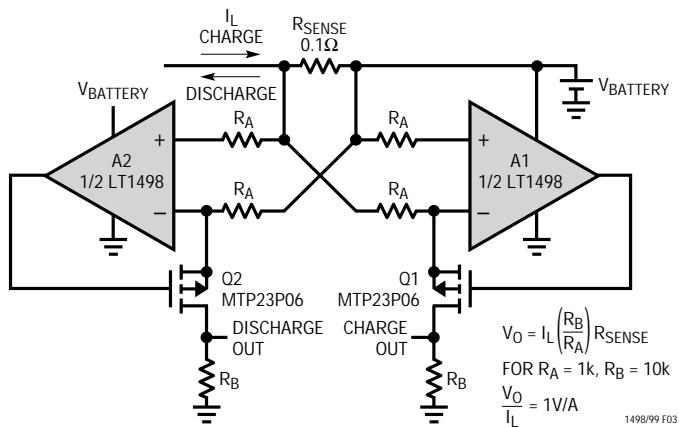


図3. 双方向電流センサ

関連部品

PART NUMBER	DESCRIPTON	COMMENTS
LTC®1152	Rail-to-Rail Input and Output, Zero-Drift Op Amp	High DC Accuracy, 10µV $V_{OS(MAX)}$, 100nV/°C Drift, 1MHz GBW, 1V/µs Slew Rate, Max Supply Current 2.2mA
LT1211/LT1212	Dual/Quad 14MHz, 7V/µs, Single Supply Precision Op Amps	Input Common Mode Includes Ground, 275µV $V_{OS(MAX)}$, 6µV/°C Max Drift, Max Supply Current 1.8mA per Op Amp
LT1213/LT1214	Dual/Quad 28MHz, 12V/µs, Single Supply Precision Op Amps	Input Common Mode Includes Ground, 275µV $V_{OS(MAX)}$, 6µV/°C Max Drift, Max Supply Current 3.5mA per Op Amp
LT1215/LT1216	Dual/Quad 23MHz, 50V/µs, Single Supply Precision Op Amps	Input Common Mode Includes Ground, 450µV $V_{OS(MAX)}$, Max Supply Current 6.6mA per Op Amp
LT1366/LT1367	Dual/Quad Precision, Rail-to-Rail Input and Output Op Amps	475µV $V_{OS(MAX)}$, 400kHz GBW, 0.13V/µs Slew Rate, Max Supply Current 520µA per Op Amp
LT1490/LT1491	Dual/Quad Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amps	Max Supply Current 50µA per Op Amp, 200kHz GBW, 0.07V/µs Slew Rate, Operates with Inputs 44V Above V^- Independent of V^+